

GORETEX

جذب
مagnetism
لارج

فصل اول

اسانی بادارہی مغناطیسی

صفحہ ۳۔

INTRODUCTION TO MAGNETISM

AND MAGNETIC CIRCUITS

آشایی با مدارهای مغناطیس

مقدمه:

امروزه دنیاگی که در آن زندگی میکیم، دنیاگی الکترونیک نامیده میشود. در جهان امروزی بشر بطرز عجیبی به الکتریسیته^(۱) وابسته شده است و بدون آن زندگی بشر متمند تقریباً غیر ممکن است. اما باید خاطر نشان ساخت که پدیده حادوئی مغناطیس نیز نقش سیار عده‌ای در زندگی بشر ایفا میکد. بدون پدیده مغناطیس لوازم الکتریکی متداول از قبیل رادیو، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، و موتورها قادر بکار نخواهند بود. بطور کلی میتوان گفت با آنکه بشر به الکتریسیته وابستگی شدید پیدا کرده است ولی بدون پدیده مغناطیس قادر باستفاده از الکتریسیته نخواهیم بود. بطور خلاصه میگوئیم که بدون پدیده مغناطیس زندگی بشر متمند غیر ممکن خواهد شد.

۱-۱ تشابه بین مغناطیس و الکتریسیته:

1-1 SIMILARITIES BETWEEN MAGNETISM AND ELECTRICITY

دستگاههای^(۲) که در این کتاب مورد مطالعه قرار میگیرند تحت عنوان لوازم الکترو مغناطیسی^(۳) بررسی میشوند. بعبارت دیگر عملکرد این دستگاهها به خاصیت‌های الکتریکی و مغناطیسی آنها بستگی دارد. علاوه بر این باید خاطر نشان ساخت که عملکرد این دستگاهها به تاثیرات متقابل خواص الکتریکی و مغناطیسی آنها نیز بستگی خواهد داشت.

در این فصل لازم است مدارهای مغناطیسی^(۴) نسبتاً "ساده‌ای را مطرح کنیم تا عملکرد دستگاههای الکترو مغناطیسی را بهتر درک نماییم. در این فصل درخواهیم یافت که مدارهای مغناطیسی بسیار شبیه مدارهای الکتریکی هستند.

1-1-1 شار (ϕ)

شار^(۵) در یک مدار مغناطیسی مشابه حریان در یک مدار الکتریکی است. یک قانون کلی شرح زیر موجود است و در بیان مسائل تکیکی از آن استفاده میشود.

- | | | |
|---------------------|------------|--------------------|
| 1) Electricity | 2) Devices | 3) Electromagnetic |
| 4) Magnetic-Circuit | 5) Flux | |

$$(\text{effect}) = \frac{\text{علت}}{\text{عكس العمل (مخالفت)}} = \frac{\text{cause}}{\text{opposition}}$$

طبق این قانون شار و حریان (۱) هر دو معلول هستند. شار را سویله خطوط فرسی و موهومی در مدار مغناطیسی نشان میدهند. مدارهای مغناطیسی از قسمتهای گوناگون تشکیل شده است و مواد مصرفی برای مدارهای مغناطیسی بگونهای است که خطوط شار سهولت شکل میگیرد. این مواد را مواد فرومغناطیسی (۲) مینامند. مواد فرمغناطیسی در یک مدار مغناطیسی مشابه یک هادی (۴) خوب در یک مدار الکتریکی است. واحد شار در سیستم آحاد انگلیسی، خط (۵) (یا ماسکول) (۶) میباشد و واحد آن در سیستم آحاد بین المللی وبر (۷) میباشد (wb). من بعد در این کتاب سیستم آحاد بین المللی را با علامت اختصاری SI و سیستم آحاد انگلیسی را با علامت اختصاری ENG نشان میدهیم. باید دانست که:

$$1 \text{ weber} = 10^8 \text{ lines (or } 10^8 \text{ maxwells)} \quad (1-1)$$

یکی از کمیت‌های مهم در مدارهای مغناطیسی، جگالی شار (B) میباشد. جگالی شار مقدار شار است که از سطحی بمساحت A که عمود بر شار میباشد عبور میکند. در سیستم ENG :

$$B = \frac{\phi \text{ lines}}{A \text{ in}^2} \quad \left(\text{or } \frac{\text{maxwells}}{\text{in}^2} \right) \quad (1-2a)$$

در سیستم (SI) داریم:

$$B = \frac{\phi \text{ Wh}}{A \text{ m}^2} \quad [\text{or tesla (T)}] \quad (1-2b)$$

-
- | | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 1) Current | 2) Lines of Flux | 3) Ferromagnetic |
| 4) Conductor | 5) Line | 6) Maxwell |
| | | 7) Weber |

Example 1-1 (English)

مثال ۱-۱ (سیستم ENG) : سطح مقطع یک هسته ۳ اینچ مریع میباشد، اگر چکالی شار ۸۰,۰۰۰ lines/in² باشد مطلوبست محاسبه شار در این هسته.

حل:

$$B = \frac{\phi}{A} \quad \text{از رابطه (۲ - ۱) داریم:}$$

$$\begin{aligned} \phi &= BA = 80,000 \text{ lines/in}^2 \times 3 \text{ in}^2 \\ &= 240,000 \text{ lines (or maxwells)} \end{aligned} \quad \text{در نتیجه:}$$

Example 1-2 (SI)

مثال ۲-۱ (سیستم SI) : سطح مقطع یک هسته ۰.۴٪ متر مریع میباشد اگر چکالی شار (۱) ۱.۵ T (۲) باشد، شار در هسته را حساب کنید. تsla معادل ویر بر متر مریع میباشد.

حل:

$$B = \frac{\phi}{A} \quad \text{از رابطه (۲ - ۱) داریم:}$$

$$\begin{aligned} \phi &= BA \\ &= 1.5 \text{ T} \times 0.04 \text{ m}^2 \\ &= 0.06 \text{ Wb} \end{aligned} \quad \text{در نتیجه:}$$

۱-۱-۱ نیروی محرکه مغناطیسی:

نیروی محرکه مغناطیسی (۳) که منبع آنرا با MMF یا U نشان میدهیم مشابه نیروی محرکه الکتریکی (۴) (EMF) در مدارهای الکتریکی میباشد. همانطور که EMF باعث میگردد حریان در مدار الکتریکی برقرار شود، نیروی محرکه مغناطیسی (MMF) نیز باعث میشود که شار در مدارهای مغناطیسی بوجود آید، با توجه به قانون کلی ذکر شده در قبل EMF و MMF هردو "علت" محسب میشوند.

1) Flux-Density 2) Tesla

3) Magnetic-Motive-Force 4) Electromotive-Force

در آینهای باید اختلاف بین مدارهای الکتریکی و مدارهای مغناطیسی توجه کرد.

الف: در مدارهای الکتریکی بدون وجود EMF ، حریان الکتریکی برقرار نمیشود.

ب: در مدارهای مغناطیسی بدون وجود MMF شار برقرار نمیشود.

مثال ساده مربوط به بند "ب" همان‌آن ریای دائمی (۱) (مغناطیس دائمی)

خواهد بود. آن ریای دائمی معمولاً "بشكل U" بوده و اکثر خوانندگان با آن آشنایی دارند.

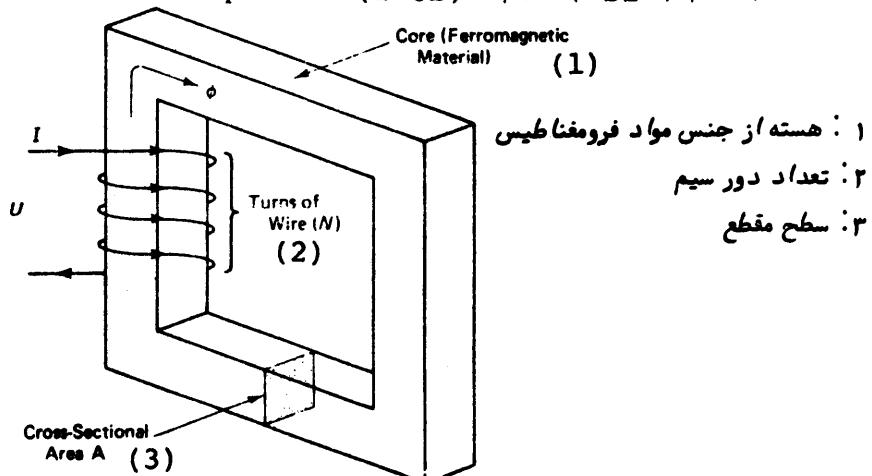
ساده‌ترین EMF در مبحث الکتریسیته همان باطری است. بر مدارهای مغناطیسی ساده‌ترین (U) MMF ، توسط سیمی (۲) که دور هسته فرو مغناطیسی پیچیده شده و توسط چریان مستقیم (۳) تغذیه میگردد بوجود می‌آید. (شکل ۱ - ۱

شکله کنید).

(U) از نظر عددی معادل حاصلضرب تعداد دورهای سیم (N) و حریان سیم (I) میباشد.

در سیستم (ENG) داریم: $U = NI$ ampere-turns (۱-۳a)

در سیستم (SI) داریم: $U = NI$ amperes (۱-۳b)



۱: هسته از جنس مواد فرومغناطیسی

۲: تعداد دور سیم

۳: سطح مقطع

شکل ۱ - ۱: نمونه ساده‌ای از طرز ایجاد نیروی محرکه مغناطیسی MMF

- 1) Permanent-Magnet
3) Direct - Current

- 2) Wire

در اینجا خاطر نشان می‌سازیم که MMF اعمال شده به مدار مغناطیسی در شکل (۱-۱) معادل مجموع افشهای MMF (۱) در کل حلقه (۲) می‌باشد. این قانون تغییر قانون ولتاژ کیرشوف (۳) است و در ادامه این فصل راجح به آن سیستر توصیح می‌گردد. سرای پیدا کردن حجهت شارکافی است که دست راست خود را در حجهت شارکافی به دور هسته قرار دهیم، در این صورت حجهت شست دست راست، جهت شارکافی هسته را نشان میدهیم.

(۱-۱) یکی دیگر از کمیت‌های مهم در مدارهای مغناطیسی، شدت میدان مغناطیسی

(H) است. از نظر عددی H اینچنین حساب می‌شود:

در سیستم (ENG) داریم:

$$H = \frac{NI}{l} \quad \text{ampere-turns/inch}$$

(1-4a)

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{E}{\mu_0 l}$$

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{\text{Amp}}{\text{Amp/m}} = \frac{\text{Amp}}{\text{m}}$$

(1-4b)

$$H = \frac{NI}{l} \quad \text{amperes/meter}$$

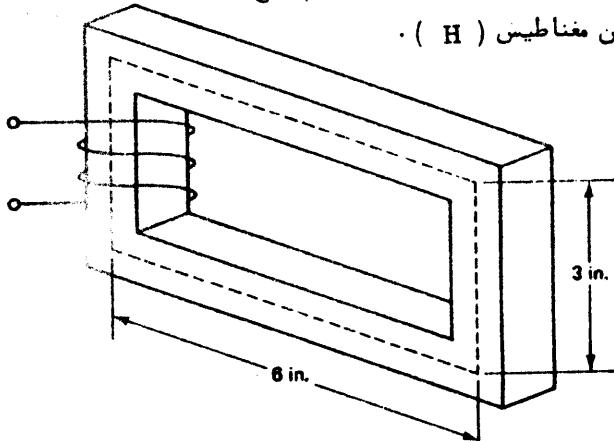
در سیستم (SI) داریم

در روابط اخیر I، طول متوسط مدار مغناطیسی می‌باشد.

Example 1-3 (English)

مثال ۱-۳ (Sistem ENG):

یک هسته فرو مغناطیسی مطابق شکل (۱-۲) مفروض است و یک سیم پیچ ۱۰۰۰ دوری به دور آن پیچیده شده است. اگر حریان سیم پیچ ۲ امپر باشد، می‌تواند محاسبه MMF و شدت میدان مغناطیسی (H) را.



شکل ۱-۲: هسته

مربوط به مثال (۱-۳)

1) MMF-Drops
2) Loop
Kirchhoff's Voltage Law

2) Loop

4) Magnetic-Field-Intensity

حل:

در اینجا فرض برآن است که سطح مقطع و جنس هسته در کل مسیر بکسان میباشد.
از رابطه (۳-۱) داریم:

$$\begin{aligned} U &= NI \\ &= 1000(2) = 2000 \text{ A-turns} \end{aligned}$$

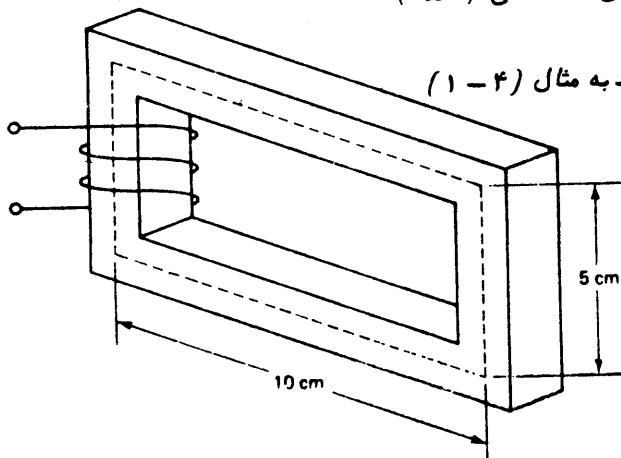
H را از رابطه (۴-۱) بدست میآوریم. ابتدا باید طول متوسط مسیر را حساب بکنیم (L). طول متوسط مسیر با توجه به خط چین‌ها در شکل (۲-۱) بدست $I = 3 \text{ in.} + 6 \text{ in.} + 3 \text{ in.} + 6 \text{ in.}$ می‌آید.

$$= 18 \text{ in.} \quad \text{لذا:}$$

$$\begin{aligned} H &= \frac{NI}{L} \\ &= 2000 \text{ A-turns}/18 \text{ in.} \\ &= 111.11 \text{ A-turns/in.} \end{aligned}$$

مثال ۴-۱ (سیستم SI):

یک هسته فرو مغناطیسی مطابق شکل (۳-۱) مفروض است و یک سیم پیچ ۱۰۰۰ دوری به دور آن بیچیده شده است. اگر حریان سیم پیچ ۲ آمپر باشد، مطلوب است محاسبه MMF و شدت میدان مغناطیسی (H) .



شکل ۳-۱: هسته مربوط به مثال (۴-۱)

حل:

در اینجا فرض برآن است که سطح مقطع و جنس هسته در کل مسیر بکسان میباشد.
از رابطه (۳-۱) داریم:

$$U = NI$$

$$= 1000(2) = 2000 \text{ A}$$

H را از رابطه (۱ - ۴) بدست می‌وریم ولی ایندا باید طول متوسط مسیر را حساب کنیم (۱ - ۵). طول متوسط مسیر را میتوان با توجه به خط چین‌ها در شکل (۱ - ۱) بدست آورد.

$$l = 5 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 5 \text{ cm} + 10 \text{ cm}$$

$$= 30 \text{ cm}$$

$$l = 30(0.01) = 0.3 \text{ m}$$

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{2000 \text{ A}}{0.3 \text{ m}} = 6666.67 \text{ A/m} \quad \text{لذا:}$$

۱-۱-۳ Reluctance (\mathcal{R})

رلوکتانس (۱) (۲) در یک مدار مغناطیسی نظری مقاومت در یک مدار الکتریکی است. با توجه به قانون کلی ذکر شده در اوایل این فصل میتوان گفت که مقاومت ورلوکتانس هر دو عکس العمل (مخالفت) محسوب میشود. فرمول مقاومت یک سیم می‌شود (۳) را بخاطر می‌وریم:

$$\mathcal{R} = \frac{\rho l}{A} \quad (1-5)$$

اگر بجای مقاومت ویژه (۴) (۵) (۶) (۷) از هدایت ویژه (۸) استفاده شود داریم:

$$R = \frac{l}{\sigma A} \quad (1-6)$$

ار رابطه (۶ - ۱) در میان اینها که مقاومت یک سیم با طول سیم نسبت مسقیم داشته ولی با هدایت ویژه و سطح مقطع مقطع نسبت معکوس دارد.

در مدار مغناطیسی، رلوکتانس اینچنین تعریف میشود:

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A} \quad (1-7)$$

در رابطه (۷ - ۱) طول متوسط مدار مغناطیسی یا هسته مورد نظر میباشد. همچنین در این رابطه A سطح مقطع موثر مدار مغناطیسی بوده و در این فصل

1) Reluctance

2) Resistance

3) Copper Wire

4) Resistivity

5) Conductivity

مانی ماشینهای الکتریکی

فرض آن است که سطح مقطع در کل مسیر مدارهای مغناطیسی یکواخت می‌باشد. در رابطه (۱-۱)، μ نفوذ پذیری مغناطیسی (پرمایلیت) (۱) مدار مغناطیسی مورد نظر نامیده شود. پر مایلیت یک ماده بیانگر شدت و ضعف آن ماده در رابطه با بوده آمدن در آن خواهد بود. عبارت دیگر تحت MMF مفروضی اگر پرمایلیت ماده بزرگ باشد، در این صورت شار بیشتری در آن ماده بوجود خواهد آمد و بالعکس اگر پر مایلیت اندک کوچک باشد در این صورت شار کمتری در آن ماده بوجود می‌آید. پرمایلیت هوا نشان میدهد.

نمی‌نمایی (ENG) داریم:

$$\mu_0 = 3.19 \times 10^{-3} \frac{\text{kilolines/in}^2}{\text{A-turns/in.}} \quad (1-8a)$$

نمی‌نمایی (SI) داریم:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T}}{\text{A/m}} \quad (1-8b)$$

با آنکه پرمایلیت هوا عددی ثابت است ولی پرمایلیت مواد فرومغناطیسی عدد ثابتی نخواهد بود.

برمایلیت باعث پیوند چگالی شار مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی نیز میگردد. این رابطه زیر بیان می‌کند.

$$B = \mu H \quad (1-9)$$

اگر μ عدد ثابتی باشد (هوا یا مواد غیر فرومغناطیسی (۲)، رابطه (۹-۱) را بیان می‌نمایی نشان داد (شکل ۴-۱). شب (۳) خط نشان داده شده در شکل پرمایلیت ماده غیر فرومغناطیسی را نشان میدهد.

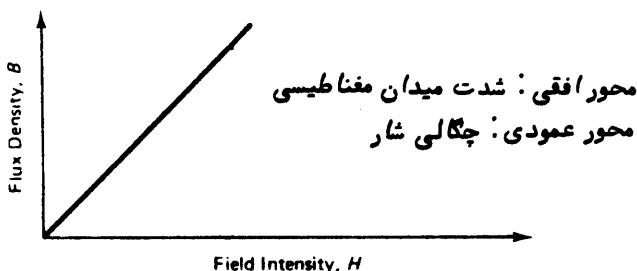
$$\text{slope} = \mu = \frac{\Delta B}{\Delta H} = \frac{B}{H}$$

توحد که در شکل (۴-۱) با افزایش H ، B نیز زیاد می‌شود و لذا این دو کمیت با رابطه خطی دارند. در اینجا یاد آور می‌شویم که اگر در مواد غیر فرومغناطیسی باشند B را میتوان از رابطه (۹-۱) بدست آورد (و بالعکس).

1) Permeability

2) Non Ferromagnetic

3) Slope



شکل ۴ - ۱: تغییرات B بر حسب H برای مواد غیر فرومغناطیسی (هوای، هو، پلاستیک و ...)

Example 1-5 (English)

مثال ۵ - ۱ (Sistem ENG):

در محفظه‌ای پر از هوا شدت میدان مغناطیسی (H) برابر 30 A-turns/in. میباشد. مطلوبست محاسبه B (چگالی شار) در این محفظه.

حل:

از رابطه (۹ - ۱) استفاده میکنیم و میدانیم برای هوا $\mu = \mu_0$ است (رابطه

(۹ - ۱)). لذا:

$$\begin{aligned} B &= \mu_0 H \\ &= 3.19 \times 10^{-3} \frac{\text{kilolines/in}^2}{\text{A-turns/in.}} (30 \text{ A-turns/in.}) \\ &= 95.7 \text{ lines/in}^2 \end{aligned}$$

Example 1-6 (SI)

مثال ۶ - ۱ (Sistem SI):

در محفظه‌ای پر از هوا، شدت میدان مغناطیسی (H) برابر 900 A/m میباشد، مطلوبست محاسبه B (چگالی شار) در این محفظه.

حل:

از رابطه (۹ - ۱) استفاده میکنیم و میدانیم برای هوا $\mu = \mu_0$ است (رابطه

(۹ - ۱)). لذا:

$$\begin{aligned} B &= \mu_0 H \\ &= 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T}}{\text{A/m}} (900 \text{ A/m}) \\ &= 0.113 \times 10^{-2} \text{ T} \end{aligned}$$

Example 1-7 (English)

مثال ۲ - ۱ (سیستم ENG) : در محفظه‌ای پراز هوای سطح مقطع ۴ اینچ مربع، شار معادل 200 000 lines میباشد، مطلوب است محاسبه H در این محفظه.

حل :

ابتدا از رابطه (۱-۲a) استفاده کرده و B را بدست می‌وریم:

$$B = \frac{\phi}{A}$$

$$= 200,000 \text{ lines}/4 \text{ in}^2$$

$$= 50,000 \text{ lines/in}^2 = 50 \text{ kilolines/in}^2$$

$$B = \mu_0 H$$

حال بسهولت میتوان گفت:

$$H = \frac{B}{\mu_0}$$

$$= \frac{50 \text{ kilolines/in}^2}{3.19 \times 10^{-3} \frac{\text{kilolines/in}^2}{\text{A-turns/in}}} = 15,670 \text{ A-turns/in.}$$

Example 1-8 (SI)

مثال ۱ - ۸ (سیستم SI) : در محفظه‌ای پراز هوا به سطح مقطع ۰/۱ متر مربع شار معادل 0.002 Wb میباشد مطلوب است محاسبه H در این محفظه.

حل :

ابتدا از رابطه (۱-۲b) استفاده کرده و B را حساب میکیم:

$$B = \frac{\phi}{A}$$

$$B = \frac{0.002 \text{ Wb}}{0.1 \text{ m}^2} = 0.02 \text{ Wb/m}^2 = 0.02 \text{ T}$$

$$B = \mu_0 H$$

$$H = \frac{B}{\mu_0}$$

$$= \frac{0.02 \text{ T}}{4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T}}{\text{A/m}}}$$

$$= 15.9 \times 10^3 \text{ A/m} = 15,900 \text{ A/m}$$

حال بسهولت میتوان گفت:

۲ - رابطه غیر خطی بین B و H در مواد فرومغناطیسی :

۱.۲ NONLINEAR EFFECTS OF FERROMAGNETIC MATERIALS

هرگاه با مدارهای مغناطیسی شامل مواد غیر فرومغناطیسی سروکار داشتیم حل این مسائل با توجه به مثالهای قبلی بسیار ساده میباشد. اما هرگاه با مدارهای مغناطیسی شامل مواد فرومغناطیسی برخوردمودیم، در این صورت وضعیت قدری پیچیده‌تر میشود، زیرا پرماینده مواد فرو مغناطیسی عدد ثابتی نمیباشد. باید توجه داشت که در مواد فرو مغناطیسی اگر B افزایش یابد، تحت شرایطی خاص پرماینده کاهش پیدا میکند، علت این امر وجود پدیده اشباع (۱) میباشد. اگر به یک هسته فرومغناطیسی، MMF اعمال کنیم در این صورت شار در هسته (۲) بوجود می‌آید. هرچه MMF را بیشتر کنیم، شار نیز بیشتر میشود، اما بالاخره به نقطه‌ای خواهیم رسید که با افزایش MMF (یا H) شار و بالنتیجه B آن افزایش چشمگیر اویله را نخواهد داشت. در این صورت میگوئیم که هسته اشباع شده است.

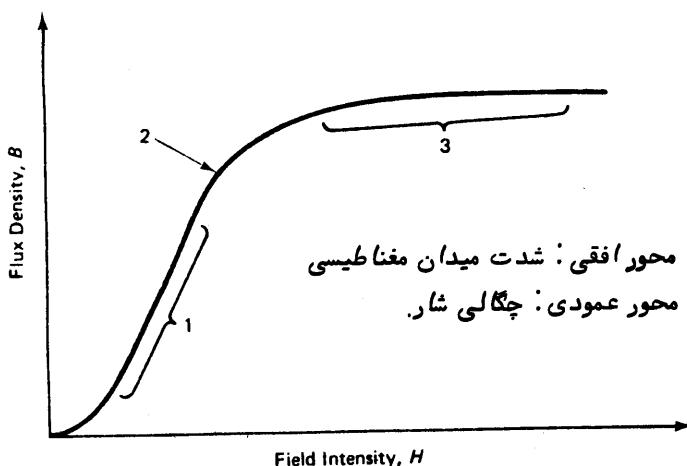
پدیده اشباع را میتوان با یک مثال ملموس بهتر توضیح داد. فرض کنید در ایستگاهی یک اتوبوس خالی وجود دارد. در ابتدا مسافران بسهولت وارد اتوبوس شده و هر مسافر یک حای خالی برای خود دست و پا میکند. هنگامی که اتوبوس پر از مسافر گردید سوار شدن مسافران بعدی خالی از اشکال نخواهد بود، در اینصورت اتوبوس نیز اشباع گردیده است (درست مثل هسته فرو مغناطیسی) البته اگر مسافران قدری بهم فشار بیاورند و بصورت فشرده درون اتوبوس قرار گیرند، همواره برای یک یا دو مسافر دیگر جای خالی باز نخواهد شد (درست مثل هسته فرو مغناطیسی) یعنی اگر هسته فرو مغناطیسی، بحال اشباع برود و باز H را زیاد کنیم، شار یا چگالی شار بمیزان ناچیزی افزایش نخواهد یافت. شکل (۵-۱) منحنی تغییرات B بر حسب H را برای هسته‌های فرو مغناطیسی متداول نشان میدهد. به این منحنی‌ها، منحنیهای $B-H$ یا منحنیهای مغناطیس شوندگی (۳) اطلاق میگردد. واضح است که منحنیهای $B-H$ برای مواد فرو مغناطیسی مختلف پکسان نخواهد بود.

با توجه بشکل (۵-۱) در میباییم که منحنی $B-H$ از سه ناحیه متمایز تشکیل شده است.

1) Saturation

2) Core

3) Magnetizing-Curve



شکل ۵ - ۱ : منحنی مغناطیسی شوندگی یک ماده فرو مغناطیسی
الف: ناحیه شماره ۱:

در این ناحیه با افزایش H ، افزایش متناسبی از B خواهیم داشت .

ب: ناحیه شماره ۲:

با افزایش بیشتر H از ناحیه شماره ۱ وارد ناحیه شماره ۲ میشویم و معمولاً "این ناحیه به پاشنه منحنی" (۱) $B-H$ معروف است . در این ناحیه اشباع شدن هسته شروع میشود .

ج: ناحیه شماره ۳:

در این ناحیه هسته کاملاً "اشباع شده است" . توجه نمائید که با افزایش H ، B بیزار ناچیزی زیاد میشود .

شکل‌های (۱-۶) و (۲-۱) منحنیهای $B-H$ را برای چدن (۲) و فولاد ریخته‌گری (۳) نشان میدهد .

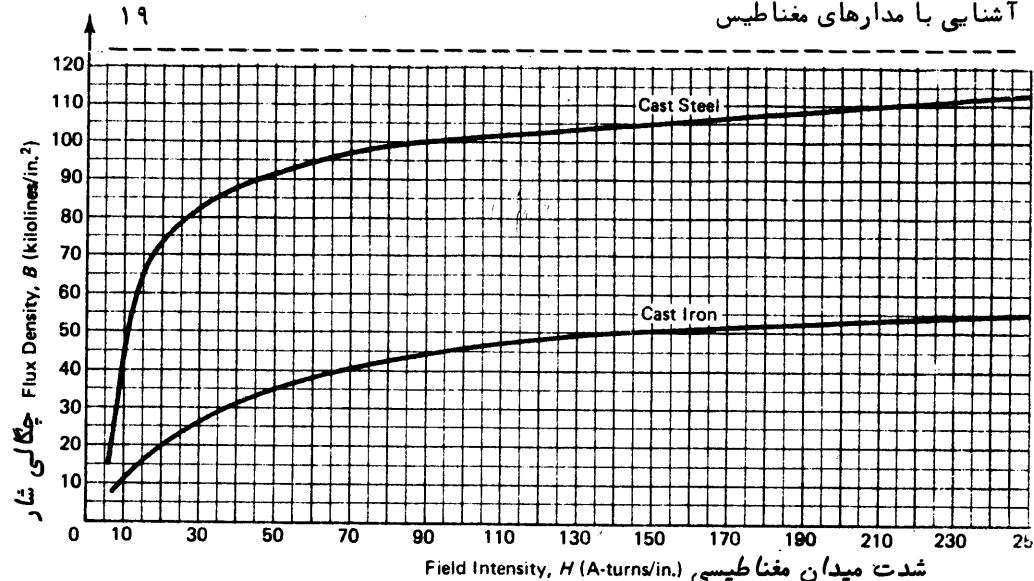
شکل (۶-۱) برای سیستم (ENG) رسم شده و شکل (۲-۱) برای سیستم (SI) ترسیم گردیده است .

1) Knee

2) Cast-Iron

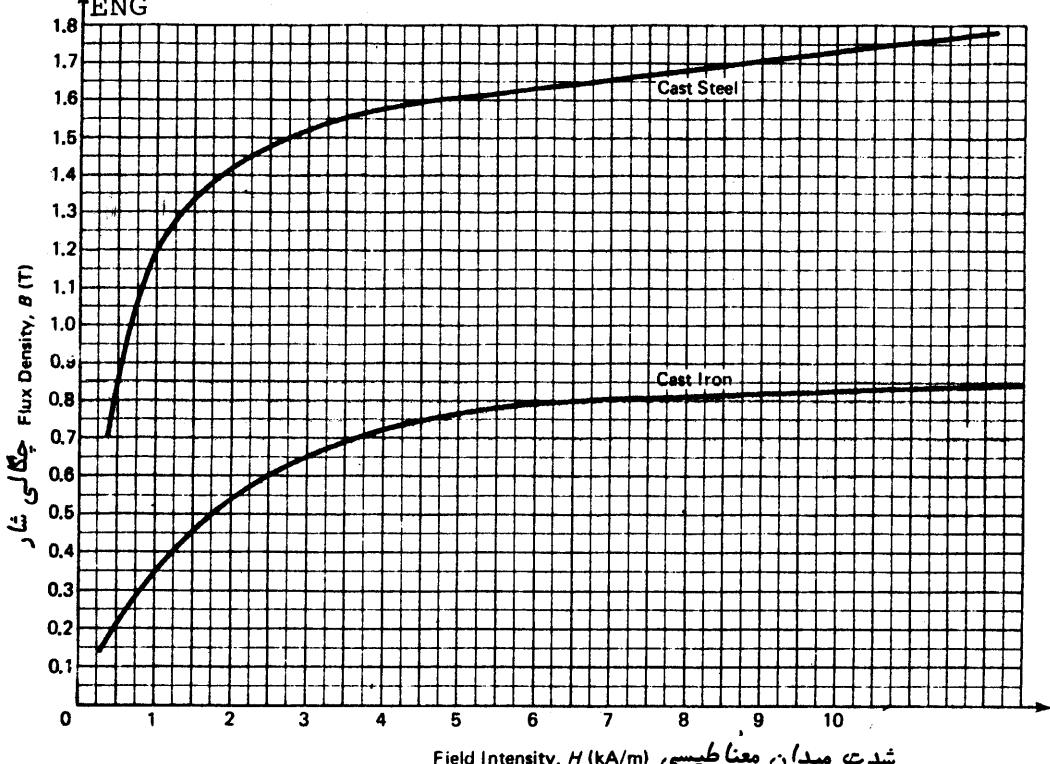
3) Cast-Steel

آشنایی با مدارهای مغناطیس



شدت میدان مغناطیسی

شکل ۶ - ۱: منحنی مغناطیس شوندگی برای فولاد ریخته‌گری و چدن در سیستم ENG



شدت میدان مغناطیسی

شکل ۶ - ۱: منحنی مغناطیس شوندگی برای فولاد ریخته‌گری و چدن در سیستم SI

مثال ۹ - ۱ (سیستم ENG) :

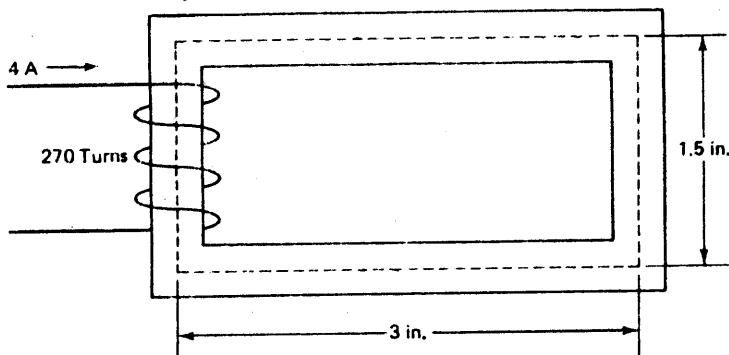
هسته‌ای مطابق شکل (۸ - ۸) مفروض است، حنس هسته از چدن بوده و سطح مقطع آن در کل مسیر یکواخت است. مطلوب است محاسبه چگالی شار (B) در این هسته:

$$\begin{aligned} l &= 3 \text{ in.} + 1.5 \text{ in.} + 3 \text{ in.} + 1.5 \text{ in.} \\ &= 9 \text{ in.} \end{aligned}$$

حل:

$$H = \frac{NI}{l} \quad \text{از رابطه (۱ - ۴a) داریم:}$$

$$= \frac{270(4)}{9} = 120 \text{ A-turns/in.}$$

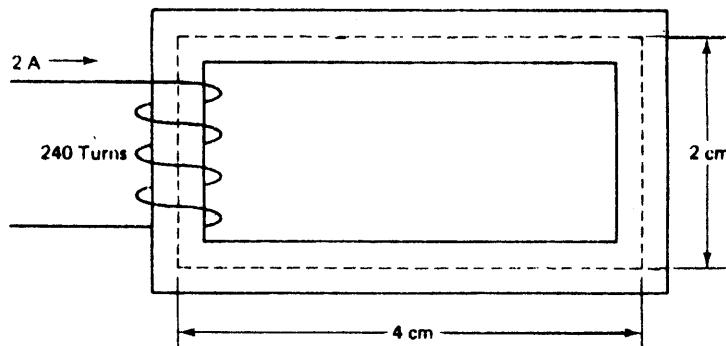


شکل ۹ - ۱ هسته مربوط به مثال ۹ - ۱

از منجتی B-H در شکل (۶ - ۱) استفاده می‌کیم. در اینجا H معلوم بوده و B را از روی منحنی می‌خوانیم (منحنی B-H برای چدن). در اینحال می‌بینیم که معادله $249 \text{ Kilolines/in}^2$ خواهد بود. در اینجا متذکر می‌شویم که دیگر نمی‌توان از رابطه (۹ - ۱) استفاده کرد.

مثال ۱۰ - ۱ (سیستم SI) :

هسته‌ای مطابق شکل (۹ - ۱) مفروض است. جنس هسته از چدن بوده و سطح مقطع آن در کل مسیر یکواخت است. مطلوب است محاسبه چگالی شار (B) در این هسته.



شکل ۹ - ۱: هسته مربوط به مثال ۱ - ۱۰

$$\begin{aligned} l &= 4 \text{ cm} + 2 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 2 \text{ cm} \\ &= 12 \text{ cm} \\ &= 12(0.01) = 0.12 \text{ m} \end{aligned}$$

از رابطه (۹ - ۱) داریم:

$$H = \frac{NI}{l}$$

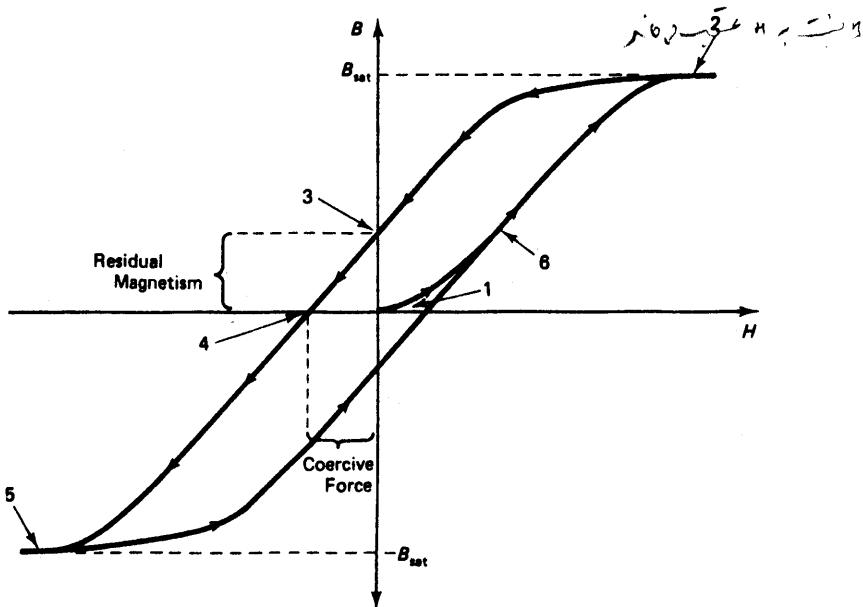
$$\begin{aligned} H &= \frac{240(2)}{0.12} \\ &= 4000 \text{ A/m} = 4 \text{ kA/m} \end{aligned}$$

حال از منحنی $B-H$ در شکل (۷ - ۱) استفاده کرده و با دانستن H ، B را میخوانیم ملاحظه میکنیم B معادل $4/21$ تسلای خواهد بود. توجه کنید که در اینجا دیگر رابطه (۹ - ۱) کارساز نخواهد بود.

۱-۲-۱ هیستریزیس:

یکی دیگر از پدیده‌های بسیار مهم و حالب که در مواد فرو مغناطیسی مشاهده میشود همان پدیده هیستریزیس است برای بیان این پدیده بهتر است از منحنی $B-H$ مطابق شکل (۱۰ - ۱) کمک گرفت. فرض میکنیم به دور هسته فرو مغناطیسی سیم

پیچی بسته شده باشد و از آن جریان عبور کند. با افزایش MMF (افزایش H) مقدار شار و B نیز افزایش میابد تا اینکه هسته اشباع شود (نقطه ۱ تا ۲ در شکل ۱۰-۱). حال اگر جریان سیم پیچ را کاهش دهیم و آنرا به صفر برسانیم در اینصورت MMF و H صفر میشوند ولی B صفر نخواهد شد (نقطه ۲ تا ۳ در شکل ۱۰-۱).



شکل ۱۰-۱: منحنی مغناطیسی شوندگی و حلقه هیستر زیس
بعارت ساده‌تر هسته خاصیت مغناطیسی خود را حفظ میکند. این خاصیت مغناطیسی پدیدار شده در هسته را پسماند مغناطیسی (۱) مینامند.

حال اگر جهت جریان را عوض کیم و بتدریج آنرا افزایش دهیم (در حالت منفی) در اینصورت B صفر خواهد شد. شدت میدان مغناطیسی منفی (H منفی)، مورد نیاز جهت صفر نمودن B را نیروی **Coercive** یا نیروی خنثی کننده نامند. (نقطه ۴ در شکل ۱۰-۱). اگر جریان بیشتر منفی گردد، دوباره هسته اشباع خواهد شد. در اینصورت پلاریته B مخالف پلاریته اولیه خواهد بود (نقطه ۵ در شکل ۱۰-۱) حال اگر دوباره جریان را بسمت صفر بیاوریم و آنرا محدوداً "ثبت نمائیم منحنی

1) Residual-Magnetism

2) Coercive-Force

در نقطه U به منحنی اولیه ملحق خواهد شد. حلقه بسته حاصله از وصل نقاط $2, 3, 4, 5$ را حلقه هیسترزیس^(۱) مینامند و این پدیده را که هرگاه B صفر گردد،

∇ صفر نخواهد شد را نیز پدیده هیسترزیس مینامند.

باید توجه داشت که:

الف: حلقه هیسترزیس نسبت به مرکز مختصات منحنی $B-H$ متقارن است.

بعارت ساده‌تر اگر B_1 مربوط به H_1 باشد در اینصورت $B_1 - H_1$ مربوط به خواهد بود.

ب: برای شدت میدان مغناطیسی (H) مفروضی دو مقدار B از روی منحنی بدست خواهد آمد و این مورد بستگی به آن دارد که آیا در مرحله افزایش H هستیم و یا در مرحله کاهش آن:

ج: هرگاه یک ماده فرو مغناطیسی خاصیت مغناطیسی پیدا نمود تنها راه غیر مغناطیسی^(۲) کردن آن ماده قراردادن آن ماده درون یک سیکل مغناطیسی شوندگی^(۳) است. بعارت ساده‌تر اگر بخواهیم B و H هر دو صفر شوند ماده فرو مغناطیسی باید درون یک سیکل مغناطیسی شوندگی قرار گیرد.

د: حداقل چگالی شار (B_{max}) (چگالی شار ماکزیمم) در یک ماده فرو مغناطیسی تابعی از درجه حرارت می‌باشد. با افزایش درجه حرارت، حداقل چگالی شار (چگالی شار مربوط به ناحیه اشاع) کاهش می‌باید. باید توجه کرد که در زیر درجه حرارت معینی (موسوم به نقطه کوری)^(۴) ماده خاصیت فرو مغناطیسی خود را از دست میدهد.

ه: مواد مختلف دارای چگالی شارهای گوناگون در ناحیه اشاع خواهند بود. از این اختلاف چگالی شارها استفاده کرده و اندازه هسته را در دستگاههای الکترو مغناطیسی طراحی می‌کنند. مثالهای زیر این موضوع را بیشتر روشن می‌کنند.

مثال ۱۱-۱ (سیستم ENG): میخواهیم در یک هسته مفروضی، ماکزیمم شاری (ϕ_{max}) معادل بود $350,000$ lines

-
- 1) Hysteresis-Loop 2) Demagnetizing
3) Magnetization-Cycle 4) Curie-Point

هسته. اگر:

الف: جنس هسته از چدن با حد اکثر چگالی شار $50 \text{ kilolines/in}^2$ باشد.

ب: جنس هسته فولاد ریخته‌گری با حد اکثر چگالی شار $100 \text{ kilolines/in}^2$

باشد.

حل:

الف: از رابطه (۲ a - ۱) داریم:

$$B_{\max} = \frac{\phi_{\max}}{A_{\min}}$$

$$A_{\min} = \frac{\phi_{\max}}{B_{\max}}$$

$$A_{\min} = \frac{350 \text{ kilolines}}{50 \text{ kilolines/in}^2} = 7 \text{ in}^2$$

لذا:

ب:

$$\begin{aligned} A_{\min} &= \frac{\phi_{\max}}{B_{\max}} \\ &= \frac{350 \text{ kilolines}}{100 \text{ kilolines/in}^2} \\ &= 3.5 \text{ in}^2 \end{aligned}$$

مثال ۱۲ - ۱ (سیستم SI):

میخواهیم در یک هسته مفروض ماقریم شاری (ϕ_{\max}) معادل 0.0035 Wb و بر بوجود آوریم. مطلوب است محاسبه سطح مقطع مینیمم برای این هسته. اگر:

الف: جنس هسته از چدن با حد اکثر چگالی شار 0.8 T تسلماً باشد.

(ب): جنس هسته فولاد ریخته‌گری با حد اکثر چگالی شار $1/6 \text{ T}$ تسلماً باشد.

حل:

$$B_{\max} = \frac{\phi_{\max}}{A_{\min}} \quad \text{(الف): از رابطه (۲ b - ۱) داریم:}$$

$$A_{\min} = \frac{\phi_{\max}}{B_{\max}} = \frac{3.5 \times 10^{-3} \text{ Wb}}{0.8 \text{ T}} = 4.375 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad \text{(لذا:}$$

$$A_{\min} = \frac{\phi_{\max}}{B_{\max}} = \frac{3.5 \times 10^{-3} \text{ Wb}}{1.6 \text{ T}} = 2.1875 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad \text{: (ب)}$$

1-3 MAGNETIC CIRCUITS

۱-۳ مدارهای مغناطیسی :

در این بخش چند مثال ساده از مدارهای مغناطیسی سری و موازی را ذکر میکنیم و بیشتر مفاهیم اینگونه مدارها را با مثالهای عددی بیان میداریم . معمولاً "مسائل مدارهای مغناطیسی را به دو طریق مطرح میسازند .

الف : طریق اول :

"یک مدار مغناطیسی موجود است . اگر بخواهیم در آن شار مفروضی بود آید ، MMF مورد نیاز را بدست می آوریم .

اینگونه مسائل مشابه مدارهای الکتریکی سری هستند که میخواهیم حریان مفروضی از این مدارها بگذرد و مجهول مساله همان نیروی محرکه الکتریکی یا EMF خواهد بود . همانطور که میدانیم حل اینگونه مدارهای الکتریکی بسیار ساده است ، یعنی تمامی افتہای RI را در کل مسیر حساب نموده و با یکدیگر حجم میکیم تا (EMF) مورد نظر بدست آید . در مدارهای مغناطیسی باید عملیات زیر را انجام داد .

۱ - با دانستن شار (ϕ) و سطح مقطع باید B را حساب کرد .

۲ - با معلوم شدن B و دانستن چنس هسته از روی منحنیهای H - B را حساب میکنیم .

۳ - حال افتہای HL (یا همان افتہای MMF ^(۱)) را در دور حلقه حساب کرده و مجموع افتہای HL همان MMF مورد نیاز (کل) خواهد بود .

ب : طریق دوم :

"یک مدار مغناطیسی موجود است ، اگر MMF اعمال شده معلوم باشد ، شار در مدار مغناطیسی را بدست آورید .

این گونه مسائل قدری پیچیده است و ما در این کتاب از طرح اینگونه مسائل خودداری میکیم ، زیرا هدف این کتاب ساده نگری نسبت به مسائل مدارهای مغناطیسی است .

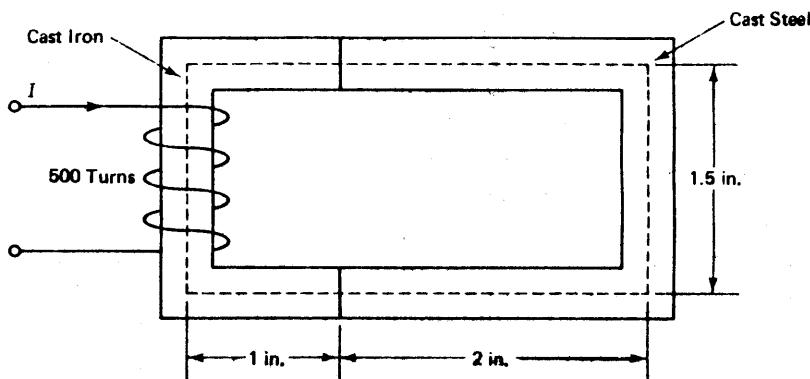
۱) MMF - Drops

مثال ۱۳ - ۱. (سیستم ENG)

هسته‌ای مطابق شکل (۱ - ۱۱) مفروض است سطح مقطع در کل هسته یکواخت بوده و معادل $1/25$ اینچ مربع است. اگر بخواهیم شار در هسته باشد، مطلوبست:

(الف) MMF مورد نیاز که باید توسط سیم پیچ بوده آید.

(ب) حریان در سیم پیچ.



شکل ۱۱ - ۱: هسته مربوط به مثال ۱۳ - ۱

: حل

برای حل این مساله خدولی مطابق حدول (۱ - ۱) تشکیل میدهیم. هسته مورد نظر در این مساله از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول از جنس چدن بوده و قسمت دیگر از جنس فولاد ریخته‌گری است.

جدول ۱ - ۱

Part	ϕ	A	B	H	I	HI
Cast iron	50 k	1.25	40 k	68	3.5	238
Cast steel	50 k	1.25	40 k	10	5.5	55
Total MMF						293

حال بینیم که اعداد این حدول چگونه پر شده است. برای هر دو قسمت هسته داریم:

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{50 \text{ k}}{1.25} = 40 \text{ kilolines/in}^2$$

با توجه به شکل (۶ - ۱) میتوان H را برای این دو قسمت بیدا کرد .
برای چدن داریم :

$$\begin{aligned}l &= 1 \text{ in.} + 1.5 \text{ in.} + 1 \text{ in.} \\&= 3.5 \text{ in.}\end{aligned}$$

برای فولاد ریخته‌گری داریم :

$$\begin{aligned}l &= 2 \text{ in.} + 1.5 \text{ in.} + 2 \text{ in.} \\&= 5.5 \text{ in.}\end{aligned}$$

حال میتوان HL را برای هر دو قسمت بدست آورد .

(الف) : کل MMF مورد نیاز مجموع افتهای HL است .

$$\text{total MMF} = 238 + 55 = 293 \text{ A-turns}$$

$$\text{Total MMF} = NI$$

ب :

$$293 = 500I$$

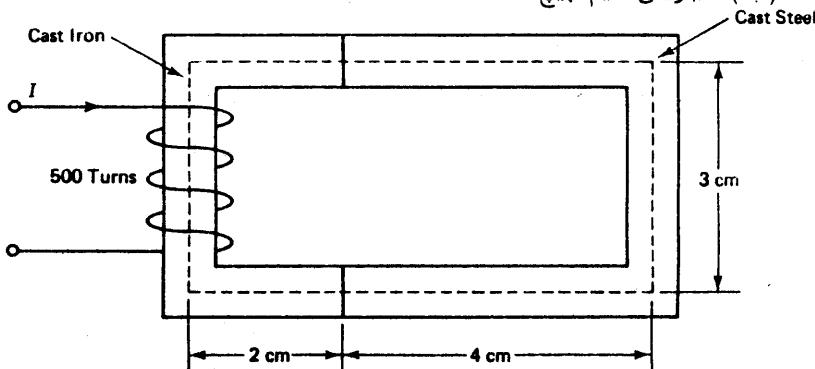
$$I = \frac{293}{500} = 0.586 \text{ A}$$

مثال ۱۴ - ۱ (SI) :

هسته‌ای مطابق شکل (۱۲ - ۱) مفروض است . سطح مقطع در کل هسته یکنواخت بوده و معادل $9/0000$ متر مربع میباشد . اگر بخواهیم شار در هسته $25/000$ وبر میباشد ، مطلوبست :

(الف) : MMF مورد نیاز که باید توسط سیم پیچ تولید شود .

(ب) : جریان سیم پیچ .



شکل ۱۲ - ۱ : هسته مربوط به مثال ۱۴ - ۱

حل :

برای حل این مساله جدولی مطابق حدول (۲ - ۱) تشکیل میدهیم . هسته مورد نظر در این مساله از دو قسمت تشکیل شده است ، قسمت اول از جنس چدن بوده و قسمت دیگر از جنس فولاد ریخته‌گری است .

Table 1-2

Part	ϕ	A	B	H	I	HL
Cast iron	0.75×10^{-3}	9×10^{-4}	0.83	9.4 k	0.07	658
Cast steel	0.75×10^{-3}	9×10^{-4}	0.83	0.5 k	0.11	55
Total MMF						713

حال بینیم که اعداد این حدول چگونه پر شده است . برای هر دو قسمت هسته داریم :

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{0.75 \times 10^{-3}}{9 \times 10^{-4}} = 0.83 \text{ T}$$

از شکل (۲ - ۱) میتوان استفاده کرد و H را در هر دو قسمت حساب کرد .

برای چدن داریم :

$$l = 2 \text{ cm} + 3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$$

$$= 7 \text{ cm} = 0.07 \text{ m} \quad HL = 0.17 \times 9.4 \times 1000 = 758$$

برای فولاد ریخته‌گری داریم :

$$l = 4 \text{ cm} + 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm}$$

$$= 11 \text{ cm} = 0.11 \text{ m} \quad HL = 0.11 \times 0.5 \times 1000 = 55$$

حال میتوان HL را برای هر دو قسمت بدست آورد .

(الف) : کل MMF مورد نیاز با مجموع افتہای HL برابر است .

$$\text{total MMF} = 658 + 55 = 713 \text{ A}$$

$$\text{Total MMF} = NI \quad : (ب)$$

$$713 = 500I$$

$$I = \frac{713}{500} = 1.43 \text{ A}$$

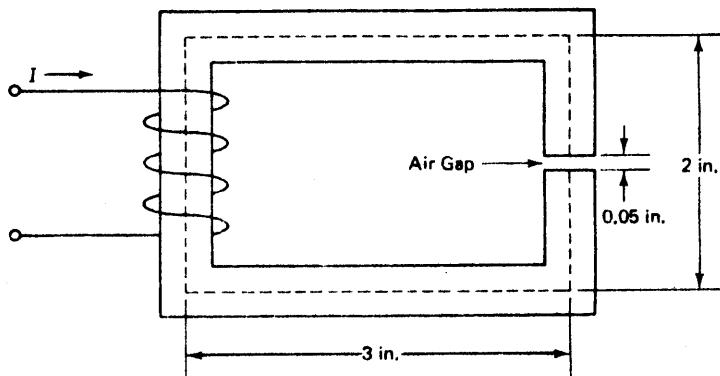
Example 1-15 (English)

مثال ۱۵ - ۱ (Sistem ENG)

هسته‌ای مطابق شکل (۱ - ۱۳) مفروض بوده و از جنس چدن ساخته شده است .

اگر بخوبیم شار در این مدار 150-kilolines باشد ، مطلوبست محاسبه MMF

مورد نیاز فرض بر آن است که سطح مقطع در کل هسته و نیز در فاصله هوایی (۱) یکسان بوده و معادل ۱۳ اینچ مربع میباشد.



شکل ۱۳ - ۱: هسته مربوط به مثال ۱۵ - ۱

حل:

این مدار مغناطیسی نیاز دو قسمت تشكیل شده است. یک قسمت از حنس جدن بوده و قسمت دیگر همان فاصله هوایی است. برای حل این مساله نیز حدولی مطابق حدول (۱ - ۲) تشكیل میدهیم

جدول ۱ - ۲

Table 1-3

Part	ϕ	A	B	H	I	HI
Cast iron	150k	3	50k	130	10	1300
Air gap	150k	3	50k	15.67×10^3	0.05	783.5
Total MMF						2083.5

حال بینیم اعداد این جدول چگونه بدست آمدند. برای B داریم:

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{150k}{3} = 50k$$

برای H هوا اینچین حساب میشود:

$$B = \mu_0 H$$

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{50 \text{ kilolines/in}^2}{3.19 \times 10^{-3} \frac{\text{kilolines/in}^2}{\text{A-turns/in}}} = 15.67 \times 10^3 \text{ A-turns/in.}$$

1) Air-gap

برای آن قسمتی که از حنس چدن است (غیر از فاصله هوایی) داریم :

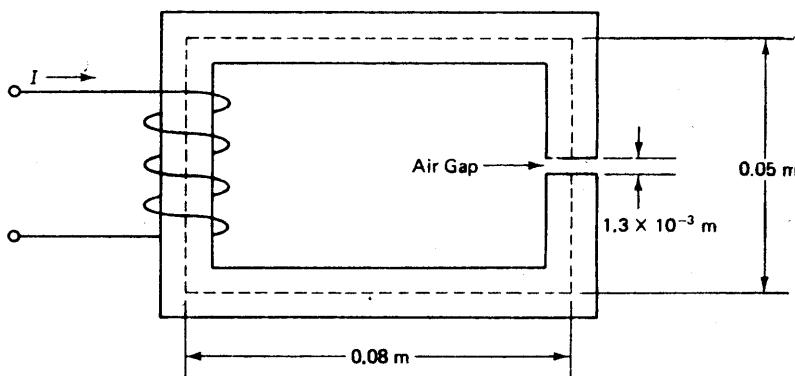
$$l = 3 \text{ in.} + 2 \text{ in.} + 3 \text{ in.} + 2 \text{ in.} = 10 \text{ in.}$$

از شکل (۶ - ۱) استفاده کرده و H را برای چدن بدست می‌وریم (۱۳۰ A-turns/in.) کل MMF مورد نیاز مجموع افتهای H است. لذا :

$$\text{total MMF} = 1300 + 783.5 = 2083.5 \text{ A-turns}$$

مثال ۱۶ - ۱ (سیستم SI) :

هسته‌ای مطابق شکل (۱۴ - ۱) مفروض بوده و از حنس چدن ساخته شده است. اگر بخواهیم شار در این مدار 15 A می‌تواند باشد، مطلوبست محاسبه MMF مورد نیاز. فرض برآن است که سطح مقطع در کل هسته و نیز در فاصله هوایی یکسان بوده و معادل 0.002 m^2 باشد.



شکل ۱۶ - ۱ : هسته مربوط به مثال ۱۶ - ۱

حل :

این مدار مغناطیسی از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت از حنس چدن بوده و قسمت دیگر همان فاصله هوایی است. برای حل این مساله جدولی مطابق جدول (۶ - ۱) تشکیل میدهیم :

Table ۱-۴

جدول ۱ - ۴

Part	ϕ	A	B	H	I	HI
Cast iron	15×10^{-4}	20×10^{-4}	0.75	4.5×10^3	0.26	1170
Air gap	15×10^{-4}	20×10^{-4}	0.75	5.97×10^3	1.3×10^{-3}	776.1
Total MMF						1946.1

حال ببینیم اعداد این جدول چگونه بدست آمداند. برای B داریم:

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{15 \times 10^{-4}}{20 \times 10^{-4}} = 0.75 \text{ T}$$

H را در فاصله هوایی اینچنین حساب میکیم:

$$B = \mu_0 H$$

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0.75 \text{ T}}{4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T}}{\text{A/m}}}$$

$$= 5.97 \times 10^3 \text{ A/m}$$

$$h_L = 1.2 \times 1.2 \times 5.97 \times 10^3 = 776.1$$

برای این قسمت که از چدن ساخته شده داریم:

$$l = 0.08 \text{ m} + 0.05 \text{ m} + 0.08 \text{ m} + 0.05 \text{ m}$$

$$= 0.26 \text{ m}$$

$$h_L = 1.2 \times 0.26 = 11.7$$

از شکل (۲ - ۱) استفاده کرده، H را بدست می‌وریم (۴.۵ kA/m). کل MMF مورد نیاز برابر مجموع افتتهای HI است. لذا:

$$\text{total MMF} = 1170 + 776.1 = 1946.1 \text{ A}$$

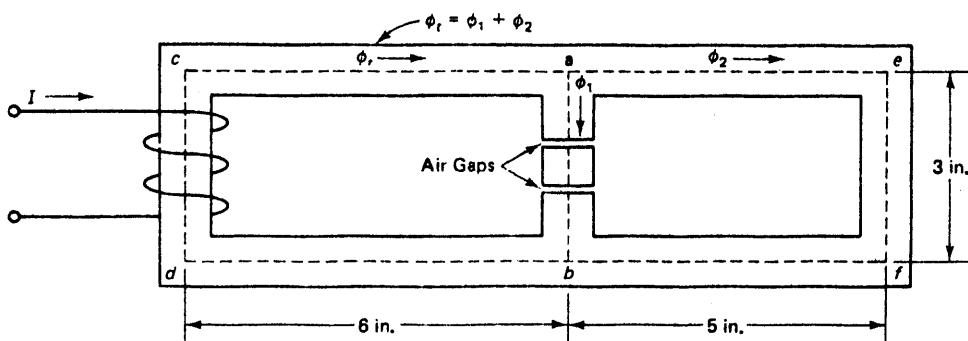
حال توجه آن است که در مثالهای (۱۵ - ۱) و (۱۶ - ۱) با آنکه طول قسمت فلزی ۲۰۰ برابر طول فاصله هوایی است، اما ۴۵٪ از کل MMF در قسمت فاصله هوایی افت پیدا میکند. بهمین دلیل درستگاههای الکترومغناطیسی فاصله هوایی راحتی الامکان کوچک استخراج میکند. بعارت دیگر هرچه فاصله هوایی کمتر باشد، کمتری حفظ ایجاد خواهد شد. در نتیجه به حریان یا تعداد دور سیم کمتری احتیاج خواهیم داشت، اما نباید این موضوع را فراموش کرد که در موتورها یا زنرаторها به فاصله هوایی نیاز داریم زیرا در غیر این صورت اصطکاک بین قسمتهای دوار و ساکن اینگونه ماشینها، فلسفه وجودی آنها را نفی خواهد کرد. معمولاً در ماشینهای الکتریکی فاصله هوایی $\frac{1}{20}$ اینچ یا 1 تا 2 میلیمتر است.

Example 1-17 (English)

مثال ۱۷ - ۱ (Sistem ENG)

هسته‌ای مطابق شکل (۱۵ - ۱) مفروض بوده و از حنس فولاد ریخته‌گری ساخته شده است. اگر بخواهیم شار در فاصله هوایی (ϕ) معادل

باشد، MMF مورد نیاز را حساب کنید. فرض برآن است که سطح مقطع در پایه وسطی هسته (a تا b) و همچنین سطح مقطع فواصل هوایی ۴ اینچ مربع باشد. سطح مقطع قسمت سمت راست هسته ۶ اینچ مربع و سطح مقطع قسمت سمت چپ هسته ۸ اینچ مربع می‌باشد. طول هر کدام از فواصل هوایی ۰/۵ اینچ است.



شکل ۱۵ - ۱: هسته مربوط به مثال ۱۷ - ۱

حل:

این هسته از سه قسمت متمایز تشکیل شده است.

۱ - قسمت مرکزی که شامل دو فاصله هوایی است (a تا b).

۲ - قسمت سمت چپ (acdb).

۳ - قسمت سمت راست (aefb).

Table 1-5

جدول ۱۵ - ۱

Part	ϕ	A	B	H	I	HI	
Left acdb	870k $(\phi_1 + \phi_2)$	8	109k	190	15	2850	
Center ab	240k (ϕ_1)	4	60k	12	3	36	
Two air gaps	240k (ϕ_1)	4	60k	18,810	0.1	1881	
Right aefb	630k ϕ_2	6	105k	147.46	13	1917	sum of MMFs

برای حل این مساله حدولی مطابق حدول (۵ - ۱) تشکیل میدهیم . حال ببینیم این جدول چگونه پر شده است .

در قسمت مرکزی هسته که شامل دو فاصله هوایی است داریم :

$$B = \frac{\phi}{A} = 60 \text{ kilolines/in}^2$$

از شکل (۶ - ۱) داریم :

$$H_{ab} = 12 \text{ A-turns/in.}$$

$$H_{\text{air gap}} = \frac{B}{\mu_0} = \frac{60}{3.19 \times 10^{-3}} = 18.81 \times 10^3 \text{ A-turns/in.}$$

حال افتهای HL را در قسمت مرکزی حساب کرده و مجموع آنها بمتابه MMF برای قسمت سمت راست (aeffb) عمل میکند .

$$H = \frac{Hl}{l} = \frac{1917}{13} = 147.46$$

از شکل (۶ - ۱) داریم :

$$B = 105 \text{ kilolines/in}^2$$

$$\phi_2 = B \times A = 105k(6) = 630 \text{ kilolines}$$

برای قسمت سمت چپ (acdb) داریم :

$$\phi_t = \phi_1 + \phi_2$$

$$= 240k + 630k = 870 \text{ kilolines}$$

$$B = \frac{870k}{8} \approx 109 \text{ kilolines/in}^2$$

از شکل (۶ - ۱) داریم :

$$H = 190 \text{ A-turns/in.}$$

$$Hl = 190 \times 15 = 2850 \text{ A-turns}$$

$$\text{total coil MMF} = 2850 + 1917$$

$$= 4767 \text{ A-turns}$$

$$2850 + 36 + 1881 = 4767 \text{ A-turns.}$$

یا :

Example 1-18 (SI)

مثال ۱۸ - ۱ (سیستم SI)

هسته‌ای مطابق شکل (۱۶ - ۱) مفروض بوده و از حنس فولاد ریخته‌گری میباشد .

اگر بخواهیم شار در فاصله هوایی (ϕ) معادل $24/00$ وبر باشد ، MMF مورد نیاز

را حساب کنید. فرض برآن است که سطح مقطع در پایه وسطی هسته (a تا b) و همچنین سطح مقطع فواصل هوایی 0.028 m متر مربع میباشد. سطح مقطع قسمت سمت راست هسته 0.005 m^2 متر مربع و سطح مقطع قسمت سمت چپ هسته 0.005 m^2 متر مربع میباشد. طول هر کدام از فواصل هوایی 0.01 m متر است.

حل:

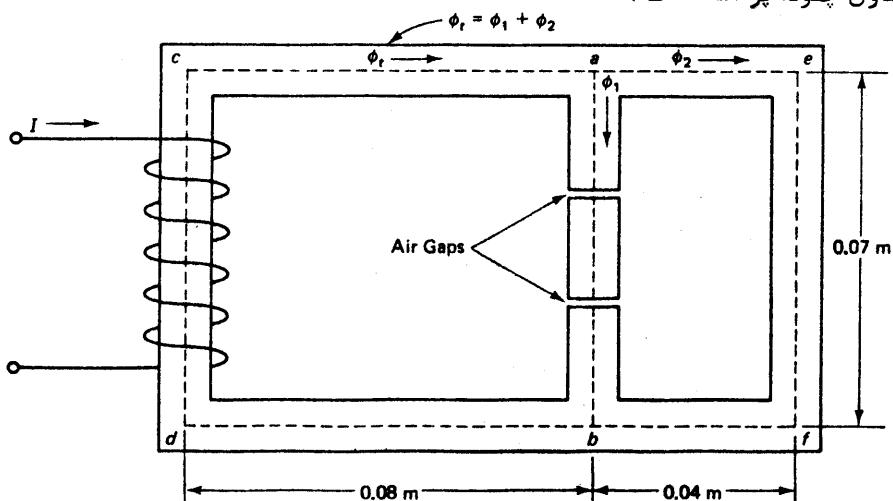
این هسته از سه قسمت متمایز ساخته شده است،

۱- قسمت مرکزی که شامل دو فاصله هوایی است،

۲- قسمت سمت چپ (acdb)

۳- قسمت سمت راست (aefb)

برای حل این مساله جدولی مطابق جدول (۶ - ۱) تشکیل میدهیم حال ببینیم این جدول چگونه پر شده است،



شکل ۱۶ - ۱. هسته مربوط به مثال ۱۸ - ۱

در قسمت مرکز که شامل دو فاصله هوایی است داریم:

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{24 \times 10^{-4}}{28 \times 10^{-4}} = 0.86 \text{ T}$$

جدول ۶ - ۱

Table 6-1

Part	ϕ	A	B	H	I	HI
Left acdb	84.2×10^{-4} $(\phi_1 + \phi_2)$	50×10^{-4}	1.68	7.75k	0.23	1782.5
Center ab	24×10^{-4} (ϕ_1)	28×10^{-4}	0.86	500	0.07	35
Two air gaps	24×10^{-4} (ϕ_1)	28×10^{-4}	0.86	684k	0.002	1368
Right aefb	60.2×10^{-4} (ϕ_2)	35×10^{-4}	1.72	9.35k	0.15	1403
						sum of MMFs

از شکل (۶ - ۱) داریم :

$$H_{ab} = 0.5 \text{ kA/m} = 500 \text{ A/m}$$

$$H_{\text{air gap}} = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0.86}{4\pi \times 10^{-7}} = 684 \text{ kA/m}$$

حال افتهای HL را در بخش مرکزی هسته حساب کرده و مجموع این افتها بمتابه MMF برای قسمت سمت راست (aefb) عمل میکند.

$$HL = 35 + 1368 = 1403 \text{ A}$$

$$H = \frac{HL}{l} = \frac{1403}{0.15} = 9.353 \text{ kA/m}$$

از شکل (۶ - ۱) داریم :

$$B = 1.72 \text{ T}$$

$$\phi_2 = B \times A = 1.72 \times 35 \times 10^{-4} = 60.2 \times 10^{-4}$$

برای قسمت سمت چپ (acdb) داریم :

$$\phi_1 = \phi_1 + \phi_2$$

$$= 24 \times 10^{-4} + 60.2 \times 10^{-4} = 84.2 \times 10^{-4}$$

$$B = \frac{84.2 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-4}} \approx 1.68 \text{ T}$$

از شکل (۶ - ۱) داریم :

$$H = 7.75 \text{ kA/m}$$

$$HL = 7.75 \text{ k} \times 0.23 = 1782.5 \text{ A}$$

$k_{v0}/$ Total coil MMF = $1782.5 + 1403 = 3185.5 \text{ A}$: یا

$$1782.5 + 35 + 1368 = 3185.5 \text{ A.}$$

SYMBOLS INTRODUCED IN CHAPTER 1

Symbol	Definition	Units	
		English	SI
۱ ϕ	Magnetic flux	lines (or maxwells)	webers (Wb)
۲ B	Flux density	lines/in ²	Wb/m ² [or tesla (T)]
۳ A	Cross-sectional area	in ²	m ²
۴ U	Magnetomotive force	ampere-turns	amperes (A)
۵ H	Magnetic field intensity	A-turns/in.	A/m
۶ l	Mean length of magnetic circuit	inches	meters
۷ N	Number of turns of wire	turns	turns
۸ R	Reluctance	A-turns lines/in ²	A/T
۹ μ	Permeability of magnetic material	lines/in ² A-turns/in.	T A/m
۱۰ μ_0	Permeability of air	3.19×10^{-3} kilolines/in ² A-turns/in.	$4\pi \times 10^{-7}$ T A/m

علام اختصاری بکار برده شده در فصل اول در دو سیستم آحادی انگلیسی و بین المللی .

- ۱ - شار مغناطیسی
- ۲ - چگالی شار
- ۳ - سطح مقطع
- ۴ - نیروی محرکه مغناطیسی (MMF)
- ۵ - شدت میدان مغناطیسی
- ۶ - طول متوسط مدار مغناطیسی
- ۷ - تعداد دور سیم پیچ
- ۸ - رلوکتانس (مقاومت مغناطیسی)
- ۹ - نفوذ پذیری مغناطیسی (پرمابلیته) ماده مغناطیسی
- ۱۰ - پرمابلیته (نفوذ پذیری مغناطیسی) هوا